

		$V_{min} [mV]$	$V_{max} [mV]$	$\Delta V [mV]$
Modalità 1	$V_{DS}$	0	100	10
	$V_{GS}$	-300	900	5
Modalità 2	$V_{DS}$	0	900	150
	$V_{GS}$	-300	900	5

Tabella 2.3: Valori delle tensioni per la misura della caratteristica  $I_D - V_{GS}$ . Per i PMOS i valori hanno segno opposto rispetto a quello riportato

## 2.2 Caratteristiche tensione-corrente

Lo scopo di questa sezione è di presentare le caratteristiche tensione-corrente dei dispositivi sotto analisi in questo lavoro di tesi. A figura 2.1 vengono mostrati i grafici  $I_D - V_{DS}$  a  $V_{GS}$  pari a  $450mV$ , mentre a figura 2.2 vengono riportati gli andamenti di della caratteristica  $I_D - V_{GS}$  con  $V_{DS} = 450mV$ .

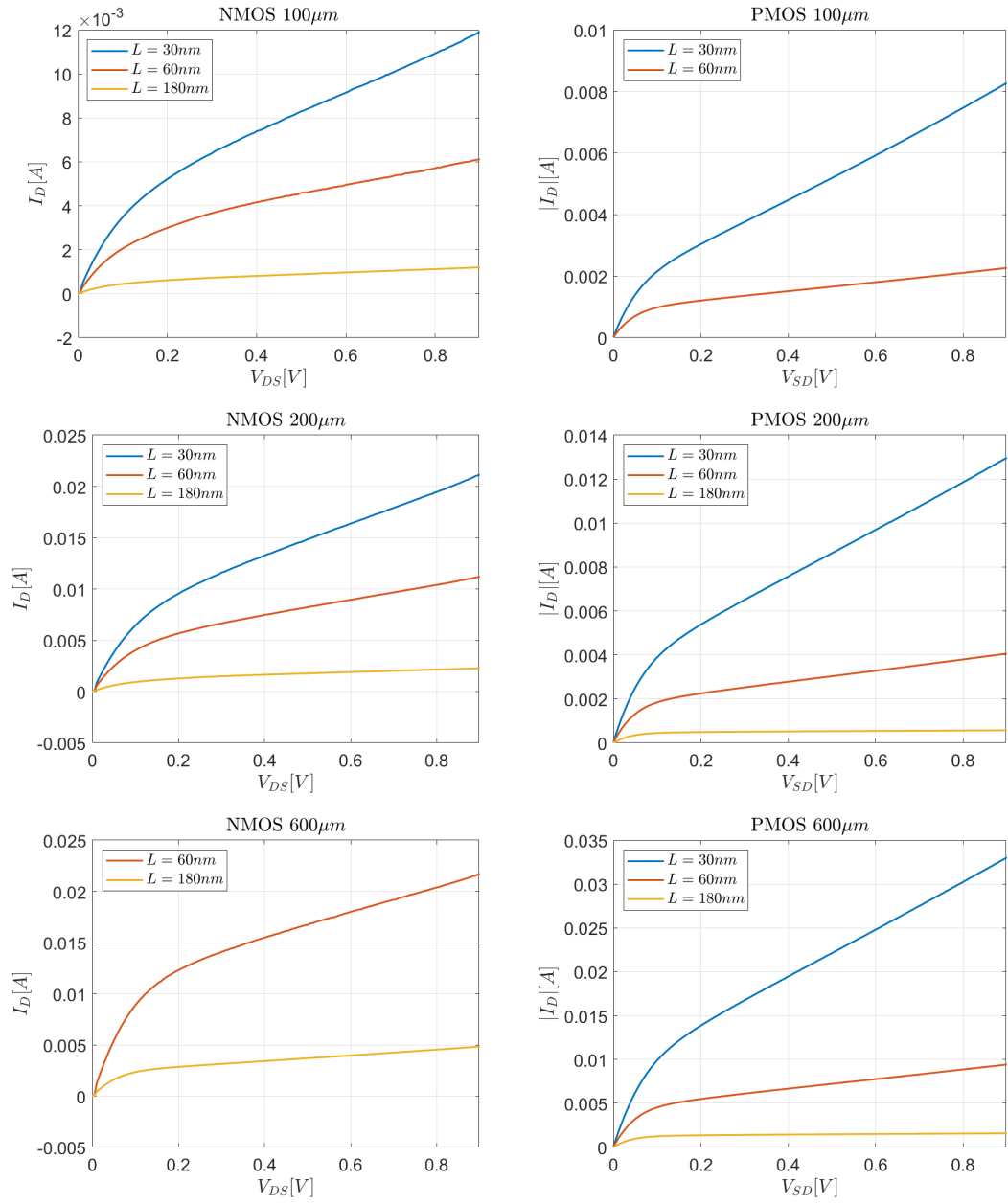


Figura 2.1: Caratteristica  $I_D - V_{DS}$  a  $V_{GS} = 450mV$  raggruppate per larghezza di canale, a sinistra MOSFET a canale N e a destra a canale P.

## 2.2 Caratteristiche tensione-corrente

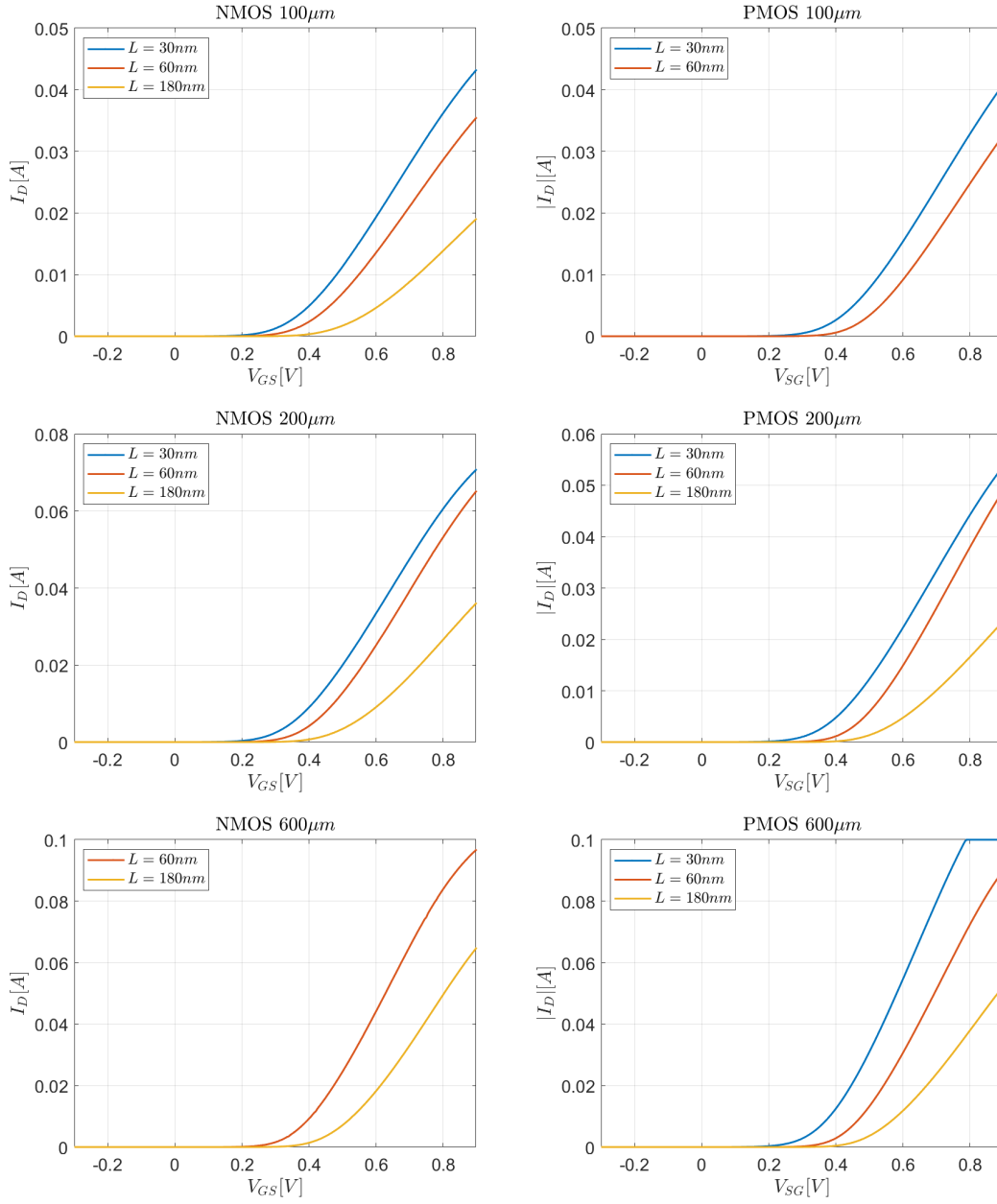


Figura 2.2: Caratteristica  $I_D - V_{GS}$  a  $V_{DS} = 450mV$  raggruppate per larghezza di canale, a sinistra MOSFET a canale N e a destra a canale P.